

2SC5039

シリコンNPNエピタキシャル形

暫定資料
(2SC5039)

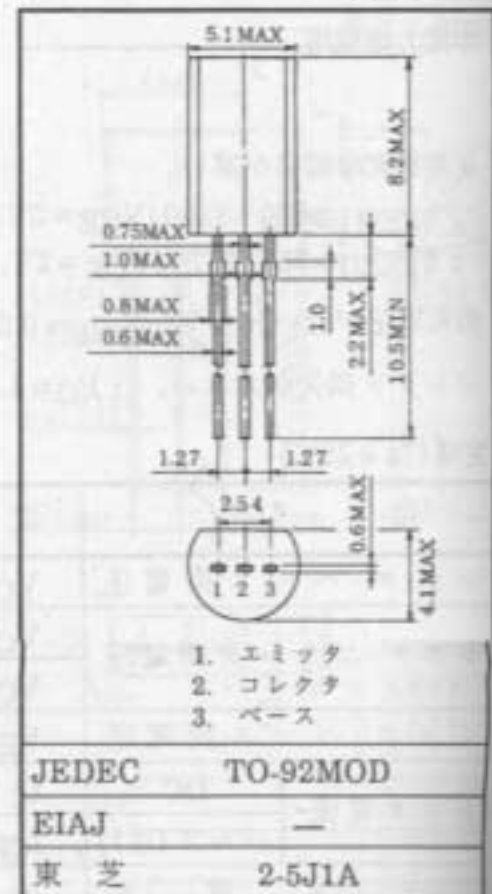
- ストロボフラッシュ用
- 中電力増幅用

- 直流電流増幅率が高くリニアリティが良好です。
 : $h_{FE(1)} = 1200 \sim 3200$ ($V_{CE} = 5V, I_C = 0.5A$)
 : $h_{FE(2)} = 500$ (標準) ($V_{CE} = 5V, I_C = 3A$)
- 飽和電圧が低い。
 : $V_{CE(sat)} = 0.3V$ (最大) ($I_C = 1A, I_B = 10mA$)

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	30	V
	V_{CEO}	25	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	DC I_C	2	A
	パルス I_{CP}	3	
ベース電流	I_B	0.8	A
コレクタ損失	P_C	900	mW
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

単位: mm



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = 30V, I_E = 0$	—	—	1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 6V, I_C = 0$	—	—	10	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, I_B = 0$	25	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 0.5A$	1200	—	3200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 5V, I_C = 3A$	300	500	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 1A, I_B = 10mA$	—	0.12	0.3	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 0.3A$	—	0.65	0.75	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V, I_C = 0.5A$	—	250	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	30	—	pF